Final datasheet

EasyPACK™ モジュール TRENCHSTOP™ 5 と RAPID 1 ダイオード内蔵 と PressFIT / NTC サーミスタ


Typical appearance

特徴

- 電気的特性
  - V_{CES} = 650 V
  - $I_{C\ nom}$ = 150 A / I_{CRM} = 300 A
  - 低スイッチング損失
  - 650 V に増加したブロッキング電圧
  - 最適なインフィニオン製ゲートドライバーは以下でご覧になれます。
    https://www.infineon.com/gdfinder
- 機械的特性
  - 低熱インピーダンスの Al_2O_3　DCB
  - コンパクトデザイン
  - PressFIT 接合 技術
  - 固定用クランプによる強固なマウンティング

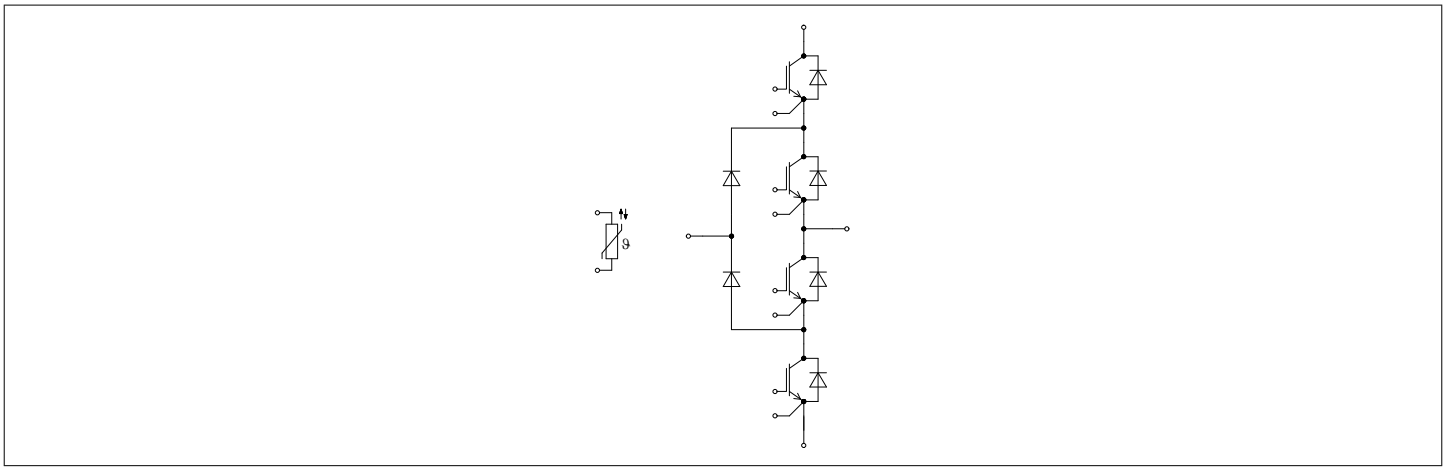
可能性のある用途

- UPS システム
- 3 レベル　アプリケーション

製品検証

- IEC 60747、60749、および 60068 の関連試験に準拠して産業用アプリケーションに適合

詳細



目次

詳細 . . . 1
特徴 . . . 1
可能性のある用途 . . . 1
製品検証 . . . 1
目次 . . . 2
1 ハウジング . . . 3
2 IGBT, T1 / T4 . . . 3
3 IGBT, T2 / T3 . . . 5
4 Diode, D1-D4 . . . 6
5 ダイオード、D5 / D6 . . . 7
6 NTC-サーミスタ . . . 8
7 特性図 . . . 9
8 回路図 . . . 17
9 パッケージ外形図 . . . 18
10 モジュールラベルコード . . . 19
改訂履歴 . . . 20
免責事項 . . . 21

1 ハウジング

表 1 絶縁協調

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
絶縁耐圧	V_{ISOL}	RMS, f = 50 Hz, *t* = 1 min	2.5	kV
絶縁試験電圧　NTC	$V_{ISOL(NTC)}$	RMS, f = 50 Hz, *t* = 1 min	2.5	kV
内部絶縁		基礎絶縁 (クラス 1, IEC 61140)	Al_2O_3	
相対トラッキング指数	*CTI*		> 200	
相対温度指数 (電気)	*RTI*	住宅	140	°C

表 2 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
内部インダクタンス	L_{sCE}			18		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{AA'+CC'}$	T_H = 25 °C, /スイッチ		1.4		mΩ
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{CC'+EE'}$	T_H = 25 °C, /スイッチ		1.5		mΩ
保存温度	T_{stg}		-40		125	°C
Mounting force per clamp	*F*		40		80	N
質量	*G*			39		g

注: *The current under continuous operation is limited to 25A rms per connector pin.*

2 IGBT, T1 / T4

表 3 最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CES}		T_{vj} = 25 °C	650	V
コレクタ電流	I_{CN}			150	A
連続 DC コレクタ電流	I_{CDC}	$T_{vj\,max}$ = 175 °C	T_H = 65 °C	110	A
繰り返しピークコレクタ電流	I_{CRM}	t_p は $T_{vj\,op}$ に制約される		300	A
ゲート・エミッタ間ピーク電圧	V_{GES}			±20	V

表 4　　電気的特性

項目	記号	条件及び注記		規格値			単位
				最小	標準	最大	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE\,sat}$	I_C = 150 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25 °C		1.42	1.90	V
			T_{vj} = 125 °C		1.53		
			T_{vj} = 150 °C		1.56		
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	V_{GEth}	I_C = 1.5 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25 °C		3.25	4.00	4.75	V
ゲート電荷量	Q_G	V_{GE} = ±15 V, V_{CC} = 400 V, T_{vj} = 25 °C			0.63		µC
内蔵ゲート抵抗	R_{Gint}	T_{vj} = 25 °C			0		Ω
入力容量	C_{ies}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			10.34		nF
帰還容量	C_{res}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			0.036		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流	I_{CES}	V_{CE} = 650 V, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C			61	µA
ゲート・エミッタ間漏れ電流	I_{GES}	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25 °C				100	nA
ターンオン遅延時間（誘導負荷）	t_{don}	I_C = 150 A, V_{CC} = 300 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 56 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.175		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.158		
			T_{vj} = 150 °C		0.153		
ターンオン上昇時間（誘導負荷）	t_r	I_C = 150 A, V_{CC} = 300 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 56 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.109		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.123		
			T_{vj} = 150 °C		0.127		
ターンオフ遅延時間（誘導負荷）	t_{doff}	I_C = 150 A, V_{CC} = 300 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 1.8 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.082		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.098		
			T_{vj} = 150 °C		0.102		
ターンオフ下降時間（誘導負荷）	t_f	I_C = 150 A, V_{CC} = 300 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 1.8 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.019		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.045		
			T_{vj} = 150 °C		0.051		
ターンオンスイッチング損失	E_{on}	I_C = 150 A, V_{CC} = 300 V, L_σ = 35 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 56 Ω, di/dt = 1120 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		10.8		mJ
			T_{vj} = 125 °C		11.3		
			T_{vj} = 150 °C		11.3		
ターンオフスイッチング損失	E_{off}	I_C = 150 A, V_{CC} = 300 V, L_σ = 35 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 1.8 Ω, dv/dt = 7320 V/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		1.22		mJ
			T_{vj} = 125 °C		2.3		
			T_{vj} = 150 °C		2.3		
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	IGBT 部（1素子当り）, λ_{grease} = 5 W/(m·K)			0.527		K/W
動作温度	$T_{vj\,op}$			-40		150	°C

3 IGBT, T2 / T3

表 5 最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CES}		T_{vj} = 25 °C	650	V
コレクタ電流	I_{CN}			150	A
連続 DC コレクタ電流	I_{CDC}	$T_{vj\,max}$ = 175 °C	T_H = 65 °C	105	A
繰り返しピークコレクタ電流	I_{CRM}	t_p は $T_{vj\,op}$ に制約される		300	A
ゲート・エミッタ間ピーク電圧	V_{GES}			±20	V

表 6 電気的特性

項目	記号	条件及び注記		規格値			単位
				最小	標準	最大	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE\,sat}$	I_C = 150 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25 °C		1.42	1.90	V
			T_{vj} = 125 °C		1.53		
			T_{vj} = 150 °C		1.56		
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	V_{GEth}	I_C = 1.5 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25 °C		3.25	4.00	4.75	V
ゲート電荷量	Q_G	V_{GE} = ±15 V, V_{CC} = 400 V, T_{vj} = 25 °C			0.63		µC
内蔵ゲート抵抗	R_{Gint}	T_{vj} = 25 °C			0		Ω
入力容量	C_{ies}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			10.34		nF
帰還容量	C_{res}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			0.036		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流	I_{CES}	V_{CE} = 650 V, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C			61	µA
ゲート・エミッタ間漏れ電流	I_{GES}	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25 °C				100	nA
ターンオン遅延時間（誘導負荷）	t_{don}	I_C = 150 A, V_{CC} = 300 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 20 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.065		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.061		
			T_{vj} = 150 °C		0.059		
ターンオン上昇時間（誘導負荷）	t_r	I_C = 150 A, V_{CC} = 300 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 20 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.039		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.045		
			T_{vj} = 150 °C		0.047		
ターンオフ遅延時間（誘導負荷）	t_{doff}	I_C = 150 A, V_{CC} = 300 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 1 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.079		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.096		
			T_{vj} = 150 °C		0.099		

(続く)

表 6 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記		規格値			単位
				最小	標準	最大	
ターンオフ下降時間（誘導負荷）	t_f	I_C = 150 A, V_{CC} = 300 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 1 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.019		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.039		
			T_{vj} = 150 °C		0.046		
ターンオンスイッチング損失	E_{on}	I_C = 150 A, V_{CC} = 300 V, L_σ = 35 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 20 Ω, di/dt = 3050 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		3.85		mJ
			T_{vj} = 125 °C		4.03		
			T_{vj} = 150 °C		4.03		
ターンオフスイッチング損失	E_{off}	I_C = 150 A, V_{CC} = 300 V, L_σ = 35 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 1 Ω, dv/dt = 7220 V/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		1.26		mJ
			T_{vj} = 125 °C		2.36		
			T_{vj} = 150 °C		2.36		
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	IGBT 部（1素子当り）, λ_{grease} = 5 W/(m·K)			0.575		K/W
動作温度	$T_{vj\,op}$			-40		150	°C

4 Diode, D1-D4

表 7 最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}		T_{vj} = 25 °C	650	V
連続 DC 電流	I_F			100	A
ピーク繰返し順電流	I_{FRM}	t_P = 1 ms		200	A
電流二乗時間積	I^2t	t_P = 10 ms, V_R = 0 V	T_{vj} = 125 °C	1020	A^2s
			T_{vj} = 150 °C	900	

表 8 電気的特性

項目	記号	条件及び注記		規格値			単位
				最小	標準	最大	
順電圧	V_F	I_F = 100 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		1.65	2.15	V
			T_{vj} = 125 °C		1.55		
			T_{vj} = 150 °C		1.50		
ピーク逆回復電流	I_{RM}	V_{CC} = 300 V, I_F = 100 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 3090 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		52		A
			T_{vj} = 125 °C		64		
			T_{vj} = 150 °C		68		

(続く)

表 8 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記		規格値			単位
				最小	標準	最大	
逆回復電荷量	Q_r	V_{CC} = 300 V, I_F = 100 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 3090 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		2.1		µC
			T_{vj} = 125 °C		4.5		
			T_{vj} = 150 °C		5.3		
逆回復損失	E_{rec}	V_{CC} = 300 V, I_F = 100 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 3090 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		0.25		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.63		
			T_{vj} = 150 °C		0.78		
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	/Diode（1素子当り）, λ_{grease} = 5 W/(m·K)			0.720		K/W
動作温度	$T_{vj\,op}$			-40		150	°C

5 ダイオード、D5 / D6

表 9 最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}		T_{vj} = 25 °C	650	V
連続 DC 電流	I_F			150	A
ピーク繰返し順電流	I_{FRM}	t_P = 1 ms		300	A
電流二乗時間積	I^2t	t_P = 10 ms, V_R = 0 V	T_{vj} = 125 °C	1940	A^2s
			T_{vj} = 150 °C	1850	

表 10 電気的特性

項目	記号	条件及び注記		規格値			単位
				最小	標準	最大	
順電圧	V_F	I_F = 150 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		1.50	2.05	V
			T_{vj} = 125 °C		1.48		
			T_{vj} = 150 °C		1.47		
ピーク逆回復電流	I_{RM}	V_{CC} = 300 V, I_F = 150 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 1120 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		31		A
			T_{vj} = 125 °C		45		
			T_{vj} = 150 °C		49		
逆回復電荷量	Q_r	V_{CC} = 300 V, I_F = 150 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 1120 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		2.2		µC
			T_{vj} = 125 °C		4.8		
			T_{vj} = 150 °C		5.9		

(続く)

表 10　(続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記		規格値			単位
				最小	標準	最大	
逆回復損失	E_{rec}	V_{CC} = 300 V, I_F = 150 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 1120 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		0.18		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.47		
			T_{vj} = 150 °C		0.61		
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	/Diode（1素子当り）, λ_{grease} = 5 W/(m·K)			0.599		K/W
動作温度	$T_{vj\,op}$			-40		150	°C

6　NTC-サーミスタ

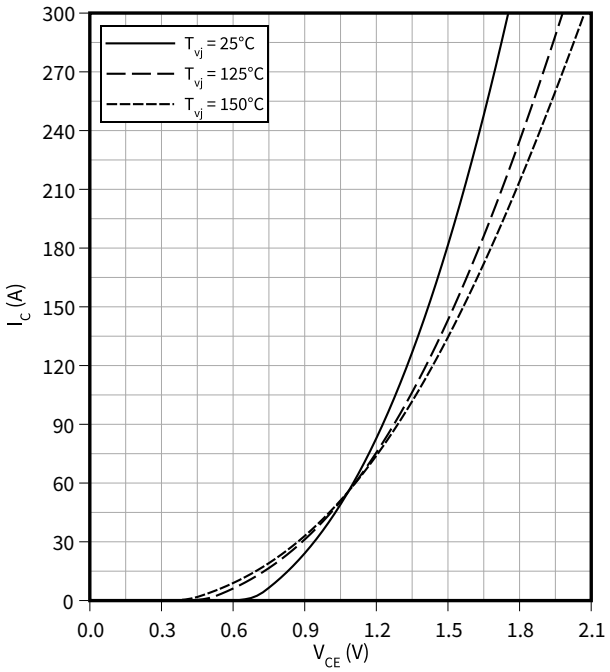
表 11　電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
定格抵抗値	R_{25}	T_{NTC} = 25 °C		5		kΩ
R_{100} の偏差	$\Delta R/R$	T_{NTC} = 100 °C, R_{100} = 493 Ω	-5		5	%
損失	P_{25}	T_{NTC} = 25 °C			20	mW
B-定数	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3375		K
B-定数	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3411		K
B-定数	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3433		K

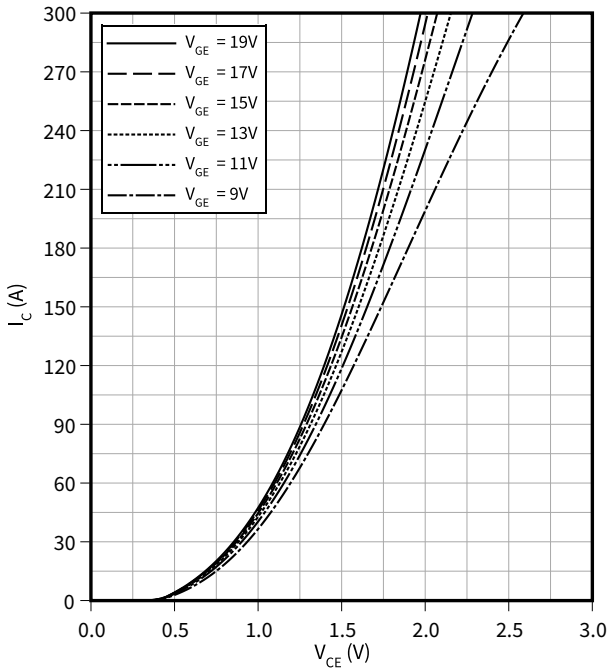
注:　NTC の解析的な説明については、AN2009-10 の 4 章を参照下さい。

7 特性図

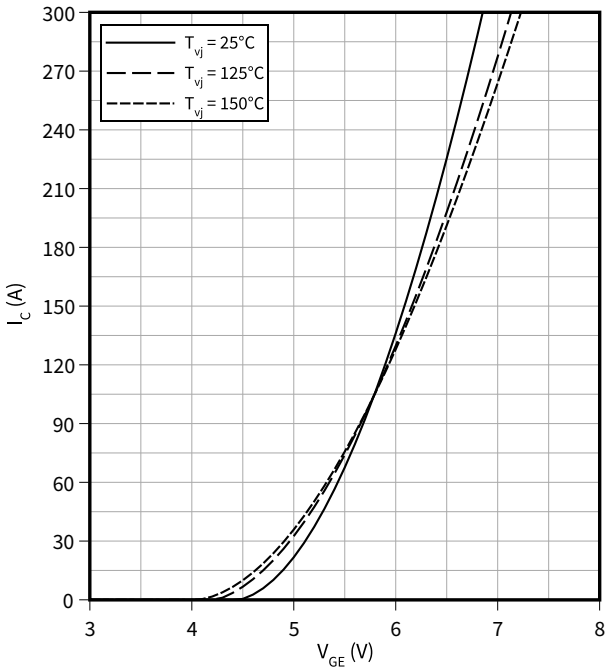
出力特性 (typical), IGBT, T1 / T4
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = 15 V



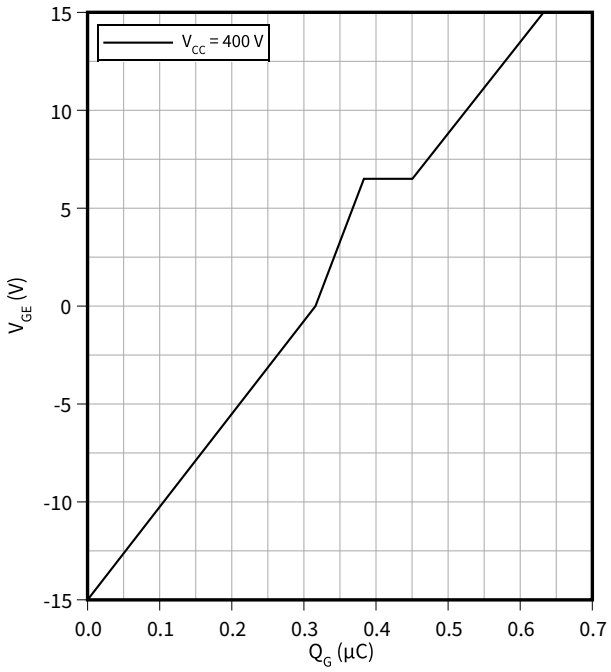
出力特性 (typical), IGBT, T1 / T4
$I_C = f(V_{CE})$
T_{vj} = 150 °C



伝達特性 (typical), IGBT, T1 / T4
$I_C = f(V_{GE})$
V_{CE} = 20 V



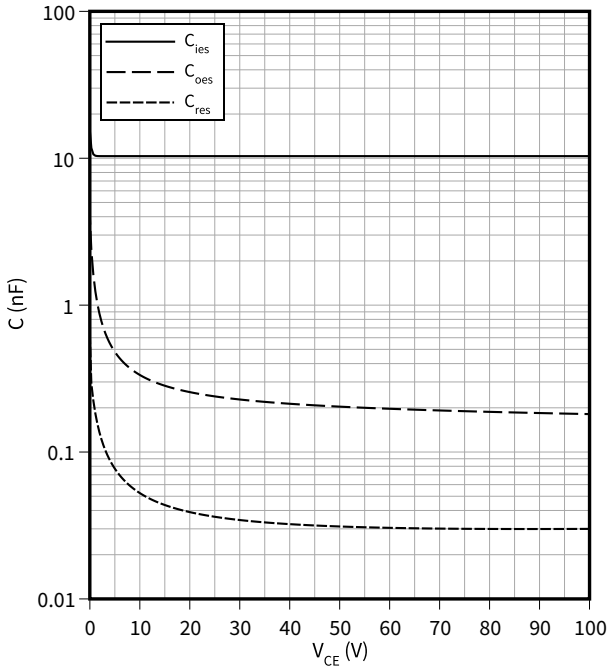
ゲート充電特性 (typical), IGBT, T1 / T4
$V_{GE} = f(Q_G)$
I_C = 150 A, T_{vj} = 25 °C



容量特性 (typical), IGBT, T1 / T4

$C = f(V_{CE})$

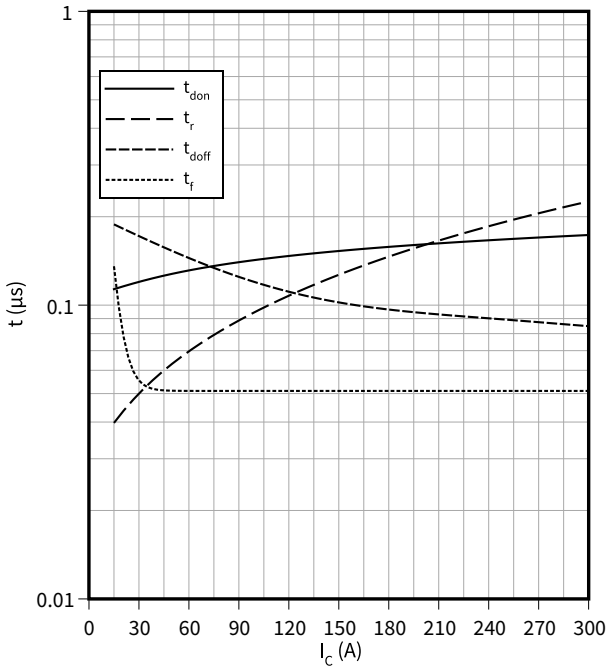
$f = 100\ kHz$, $V_{GE} = 0\ V$, $T_{vj} = 25\ °C$



スイッチング時間 (typical), IGBT, T1 / T4

$t = f(I_C)$

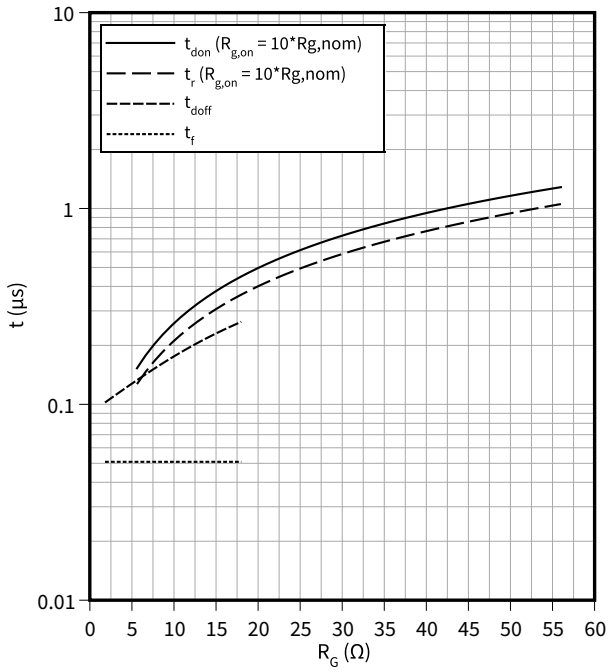
$V_{CC} = 300\ V$, $R_{Goff} = 1.8\ \Omega$, $T_{vj} = 150\ °C$, $R_{Gon} = 56\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15\ V$



スイッチング時間 (typical), IGBT, T1 / T4

$t = f(R_G)$

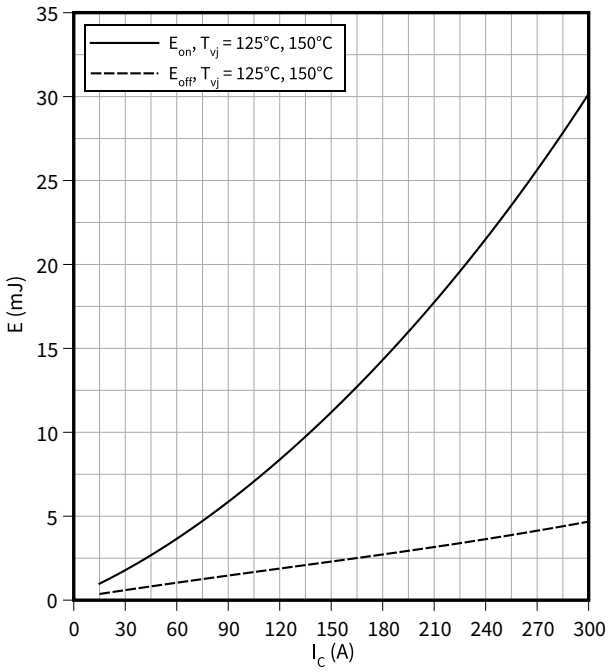
$V_{GE} = \pm 15\ V$, $I_C = 150\ A$, $V_{CC} = 300\ V$, $T_{vj} = 150\ °C$



スイッチング損失 (typical), IGBT, T1 / T4

$E = f(I_C)$

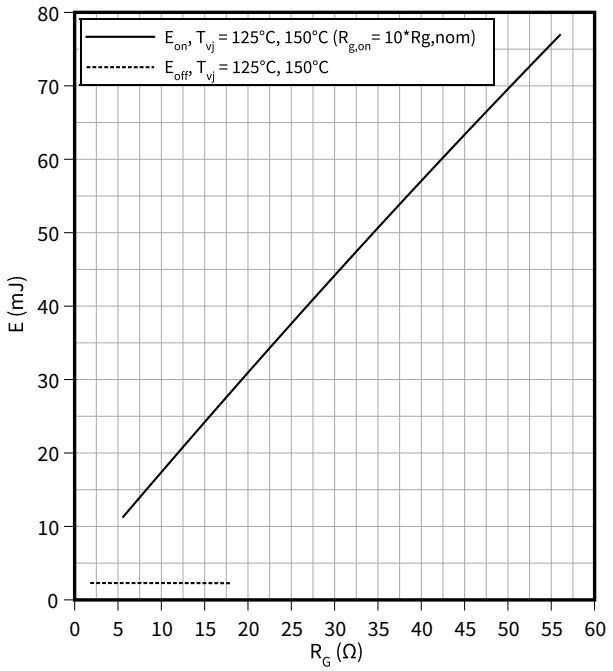
$R_{Goff} = 1.8\ \Omega$, $R_{Gon} = 56\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15\ V$, $V_{CC} = 300\ V$



スイッチング損失 (typical), IGBT, T1 / T4

$E = f(R_G)$

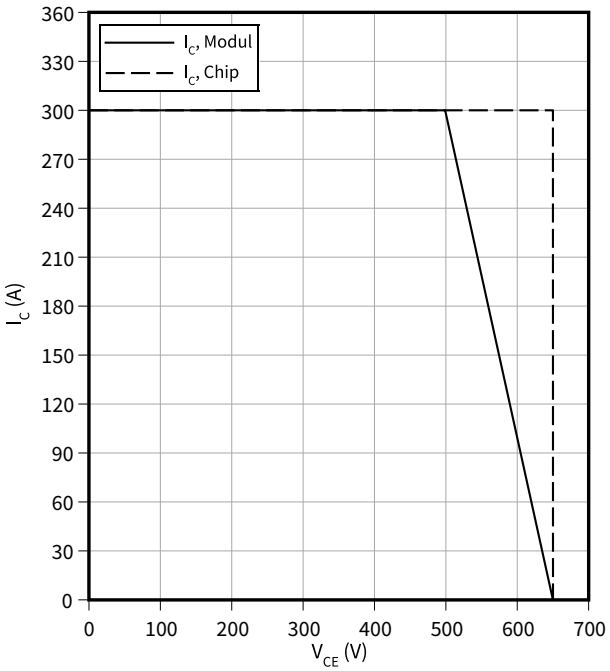
V_{GE} = ±15 V, I_C = 150 A, V_{CC} = 300 V



逆バイアス安全動作領域 (RBSOA), IGBT, T1 / T4

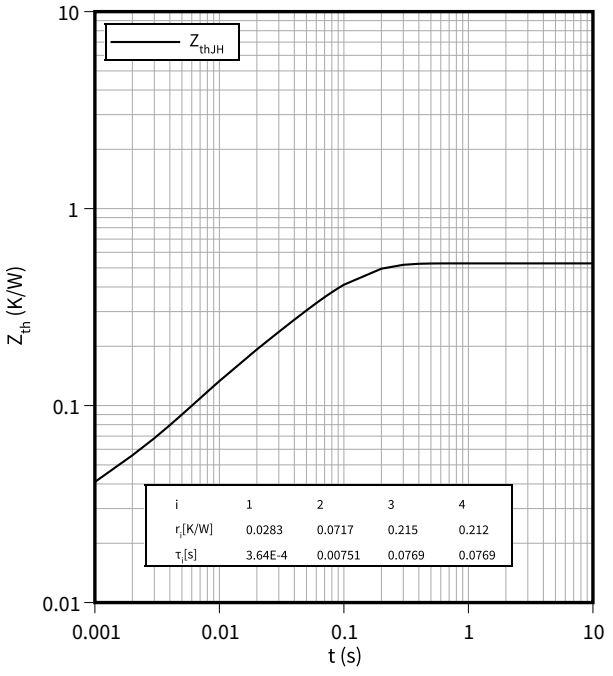
$I_C = f(V_{CE})$

R_{Goff} = 1.8 Ω, V_{GE} = ±15 V, T_{vj} = 150 °C



過渡熱インピーダンス, IGBT, T1 / T4

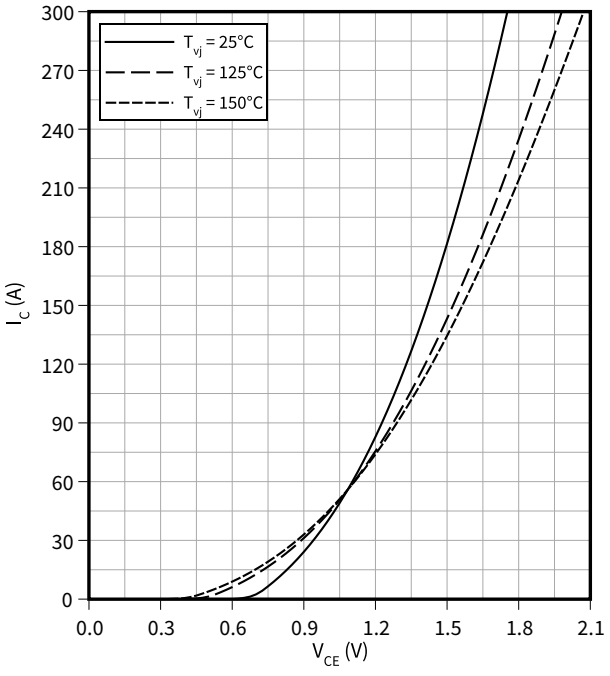
$Z_{th} = f(t)$



出力特性 (typical), IGBT, T2 / T3

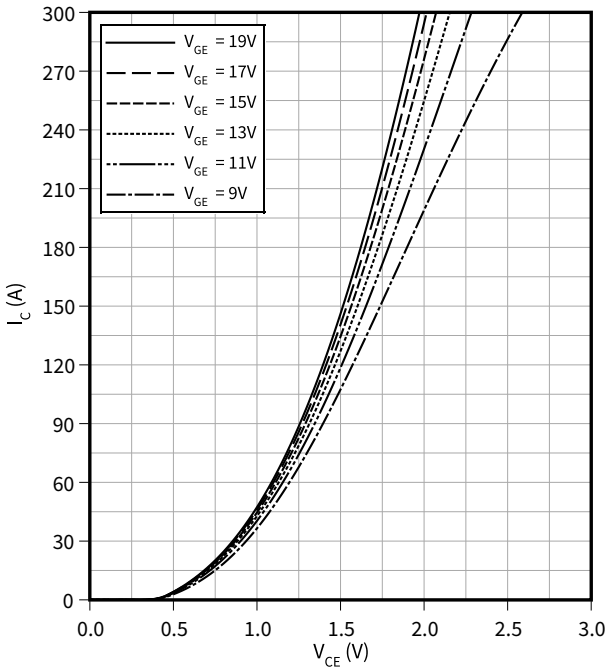
$I_C = f(V_{CE})$

V_{GE} = 15 V



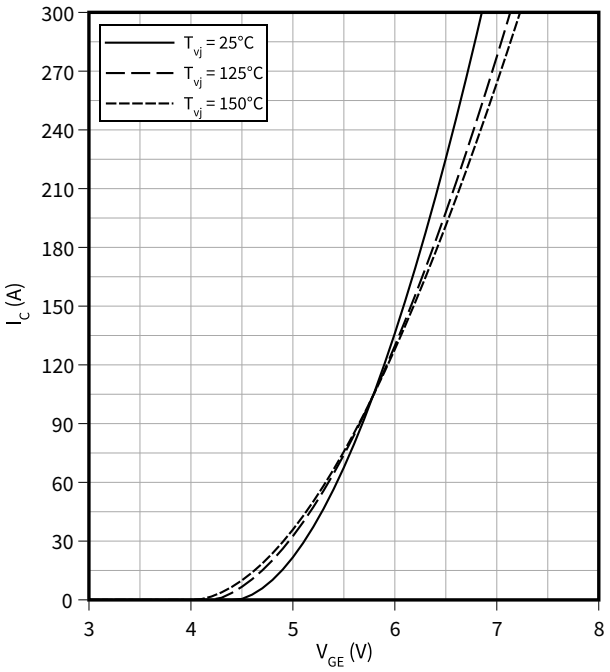
出力特性 (typical), IGBT, T2 / T3

$I_C = f(V_{CE})$
$T_{vj} = 150\ °C$



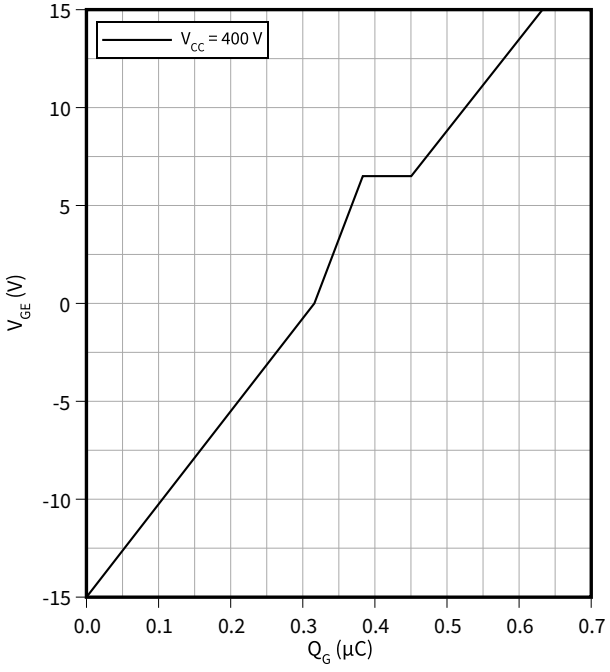
伝達特性 (typical), IGBT, T2 / T3

$I_C = f(V_{GE})$
$V_{CE} = 20\ V$



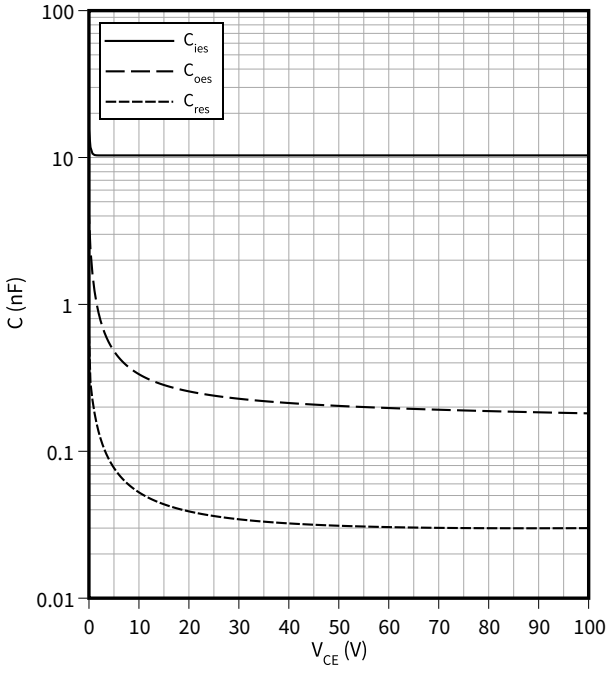
ゲート充電特性 (typical), IGBT, T2 / T3

$V_{GE} = f(Q_G)$
$I_C = 150\ A,\ T_{vj} = 25\ °C$



容量特性 (typical), IGBT, T2 / T3

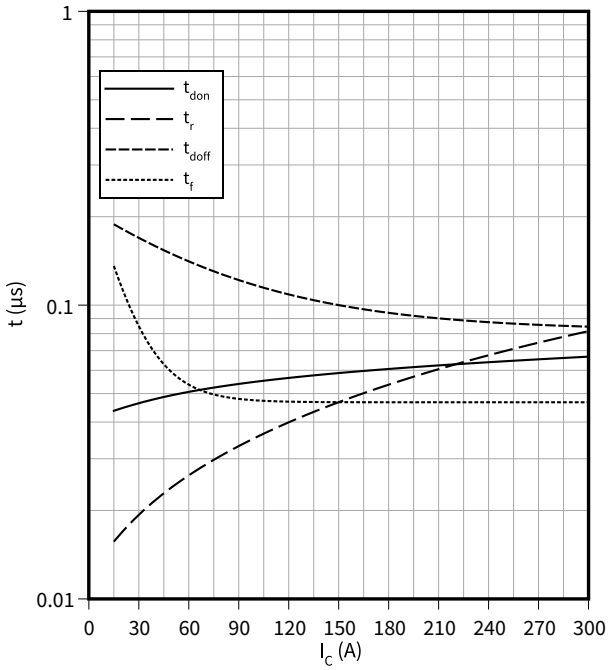
$C = f(V_{CE})$
$f = 100\ kHz,\ V_{GE} = 0\ V,\ T_{vj} = 25\ °C$



スイッチング時間 (typical), IGBT, T2 / T3

$t = f(I_C)$

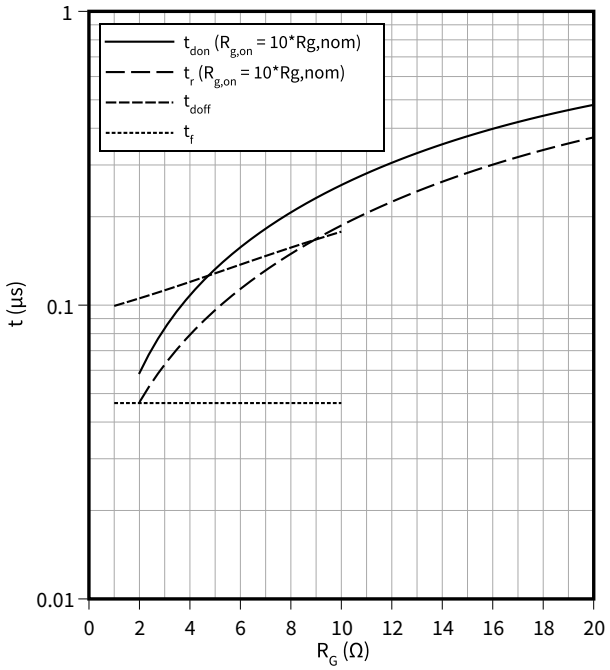
$R_{Goff} = 1\ \Omega$, $R_{Gon} = 20\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15$ V, $V_{CC} = 300$ V, $T_{vj} = 150$ °C



スイッチング時間 (typical), IGBT, T2 / T3

$t = f(R_G)$

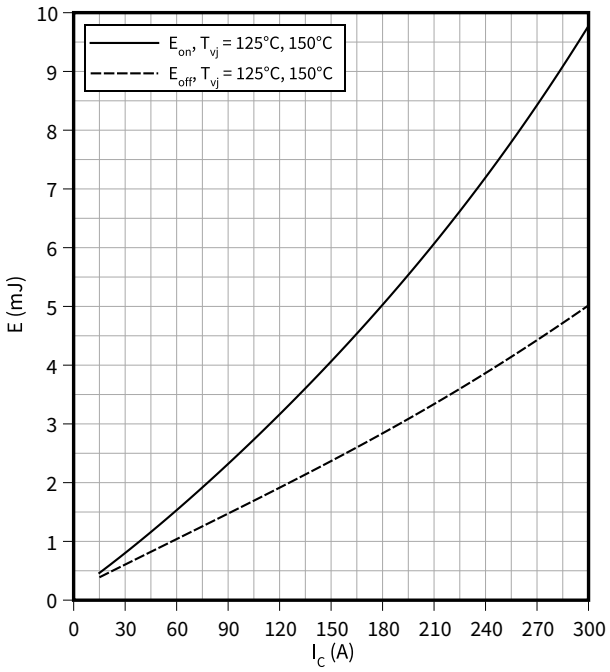
$V_{GE} = \pm 15$ V, $I_C = 150$ A, $V_{CC} = 300$ V, $T_{vj} = 150$ °C



スイッチング損失 (typical), IGBT, T2 / T3

$E = f(I_C)$

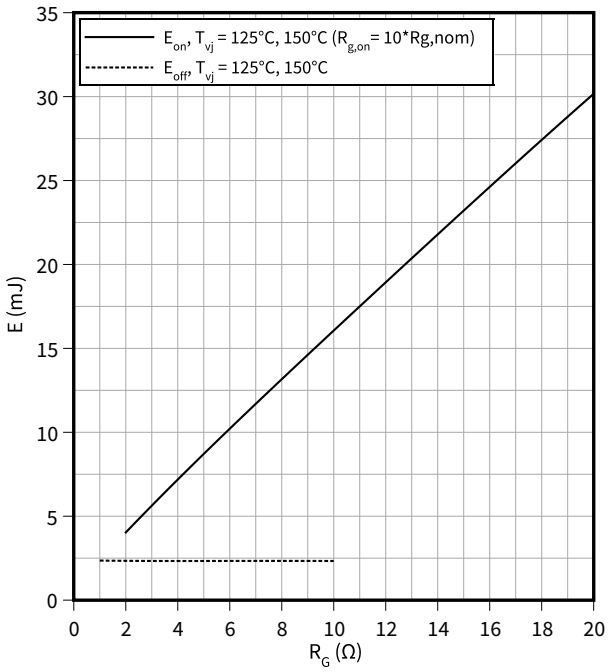
$R_{Goff} = 1\ \Omega$, $R_{Gon} = 20\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15$ V, $V_{CC} = 300$ V



スイッチング損失 (typical), IGBT, T2 / T3

$E = f(R_G)$

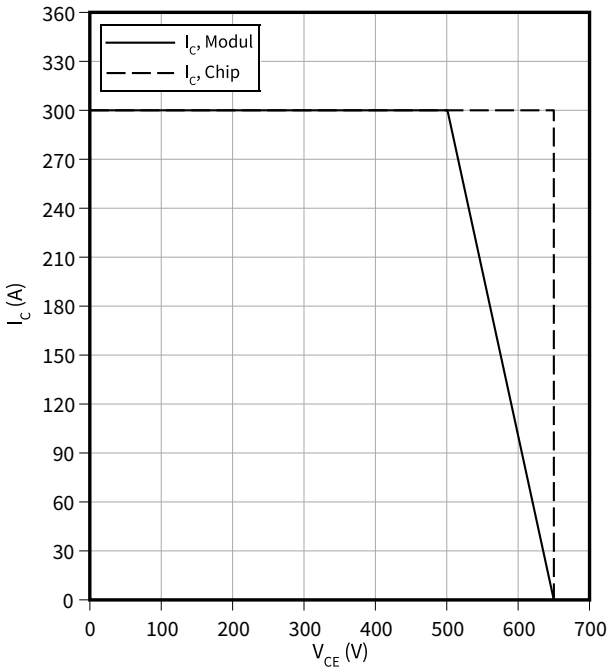
$V_{GE} = \pm 15$ V, $I_C = 150$ A, $V_{CC} = 300$ V



逆バイアス安全動作領域 (RBSOA), IGBT, T2 / T3

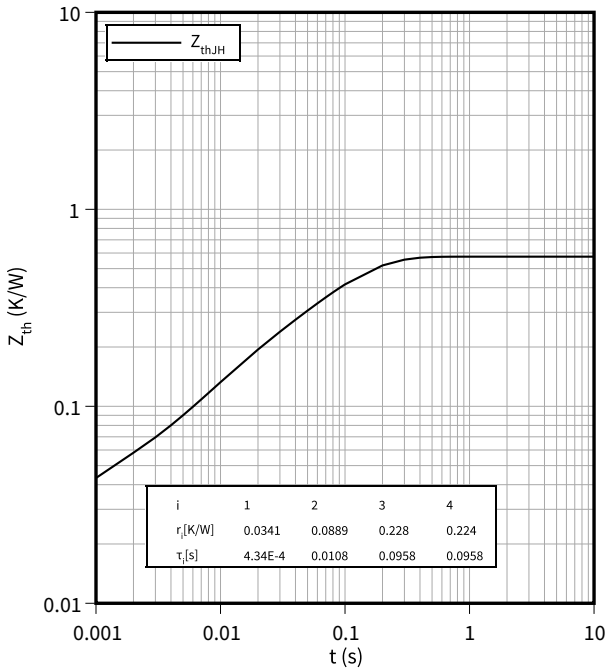
$I_C = f(V_{CE})$

$R_{Goff} = 1\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15$ V, $T_{vj} = 150$ °C



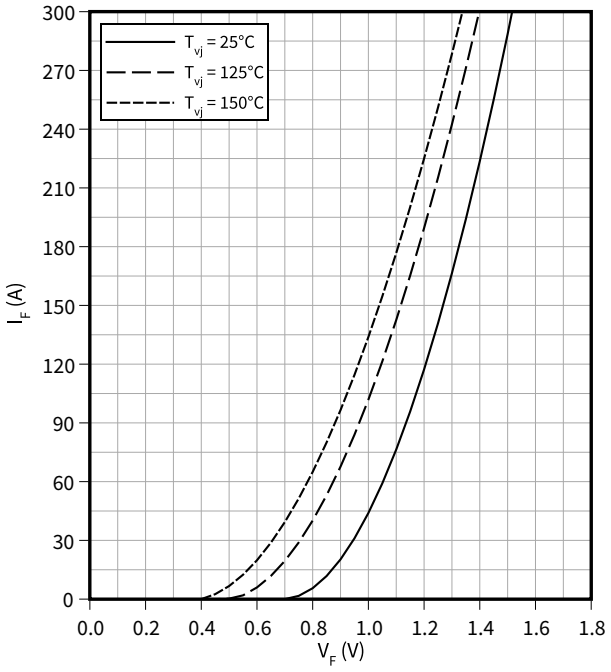
過渡熱インピーダンス, IGBT, T2 / T3

$Z_{th} = f(t)$



順電圧特性 (typical), Diode, D1-D4

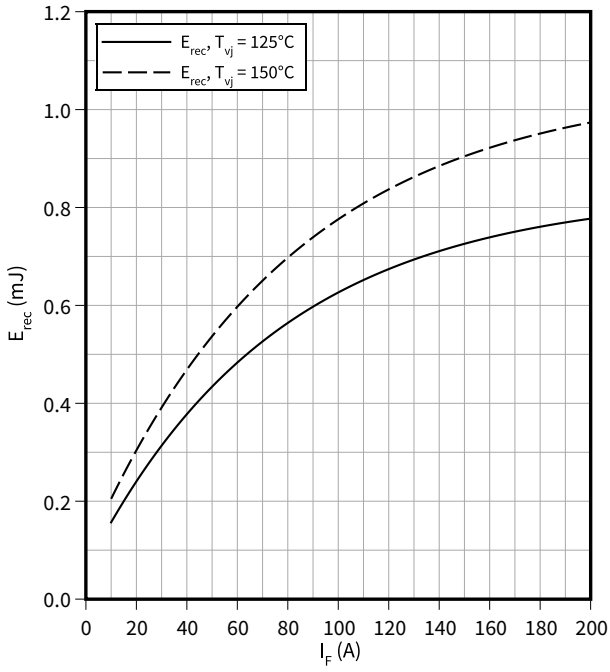
$I_F = f(V_F)$



スイッチング損失 (typical), Diode, D1-D4

$E_{rec} = f(I_F)$

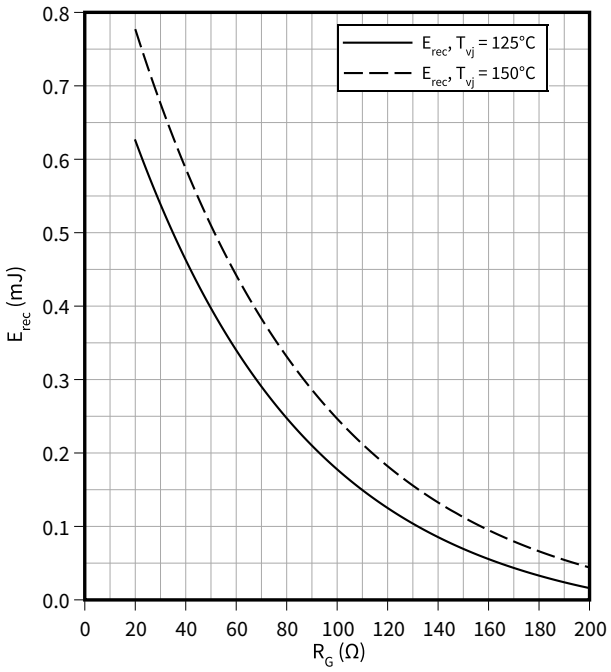
$R_{Gon} = 20\ \Omega$, $V_{CE} = 300$ V



スイッチング損失 (typical), Diode, D1-D4

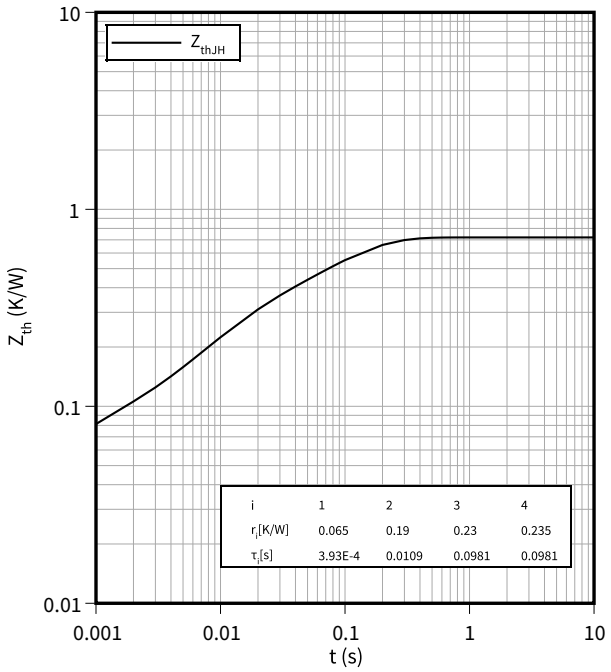
$E_{rec} = f(R_G)$

$V_{CE} = 300\ V$, $I_F = 150\ A$



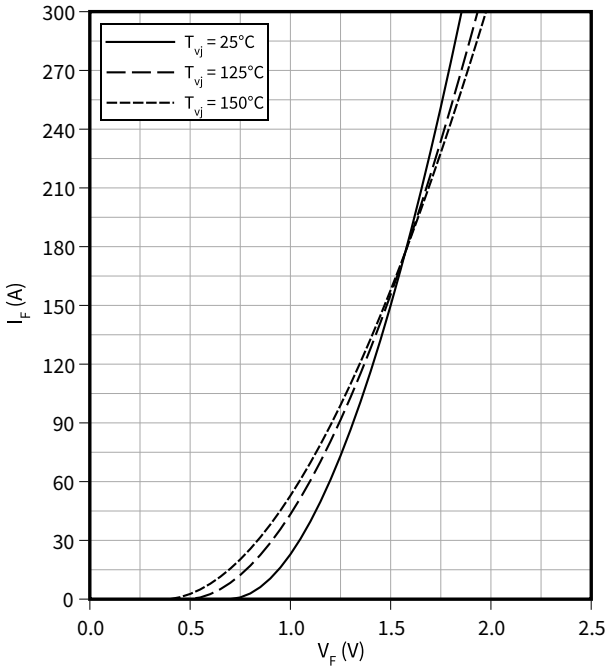
過渡熱インピーダンス, Diode, D1-D4

$Z_{th} = f(t)$



順電圧特性 (typical), ダイオード、D5 / D6

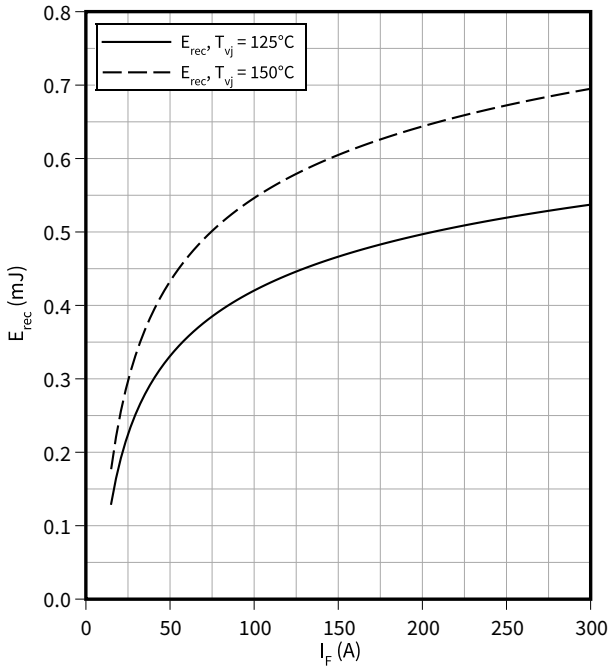
$I_F = f(V_F)$



スイッチング損失 (typical), ダイオード、D5 / D6

$E_{rec} = f(I_F)$

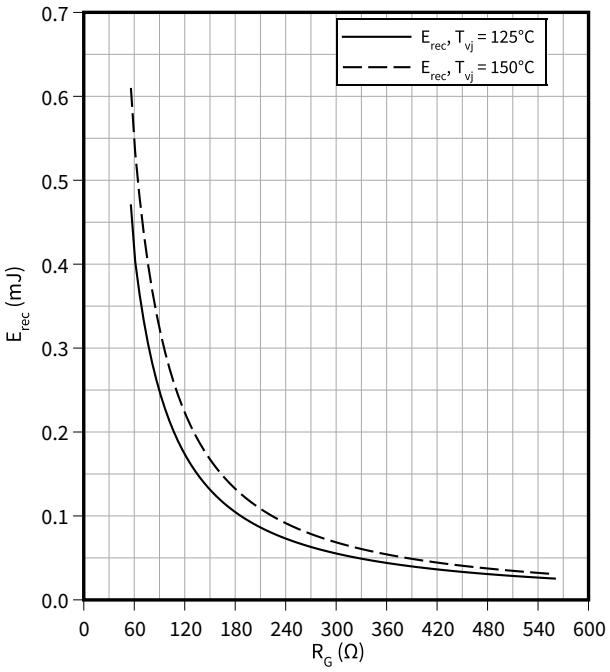
$R_{Gon} = 56\ \Omega$, $V_{CE} = 300\ V$



スイッチング損失 (typical), ダイオード、D5 / D6

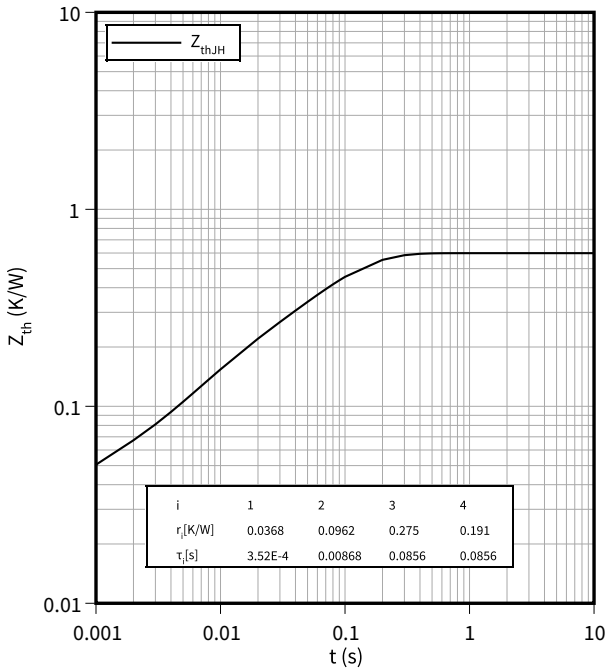
$E_{rec} = f(R_G)$

$V_{CE} = 300\ V$, $I_F = 150\ A$



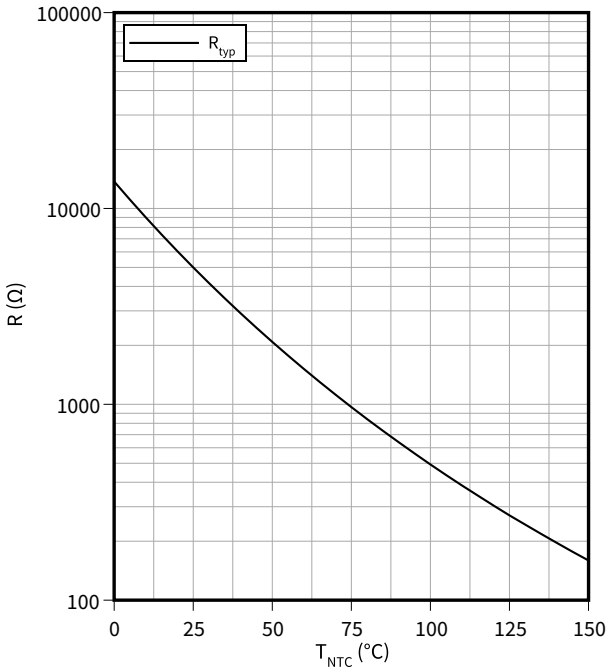
過渡熱インピーダンス, ダイオード、D5 / D6

$Z_{th} = f(t)$



サーミスタの温度特性, NTC-サーミスタ

$R = f(T_{NTC})$



8 回路図

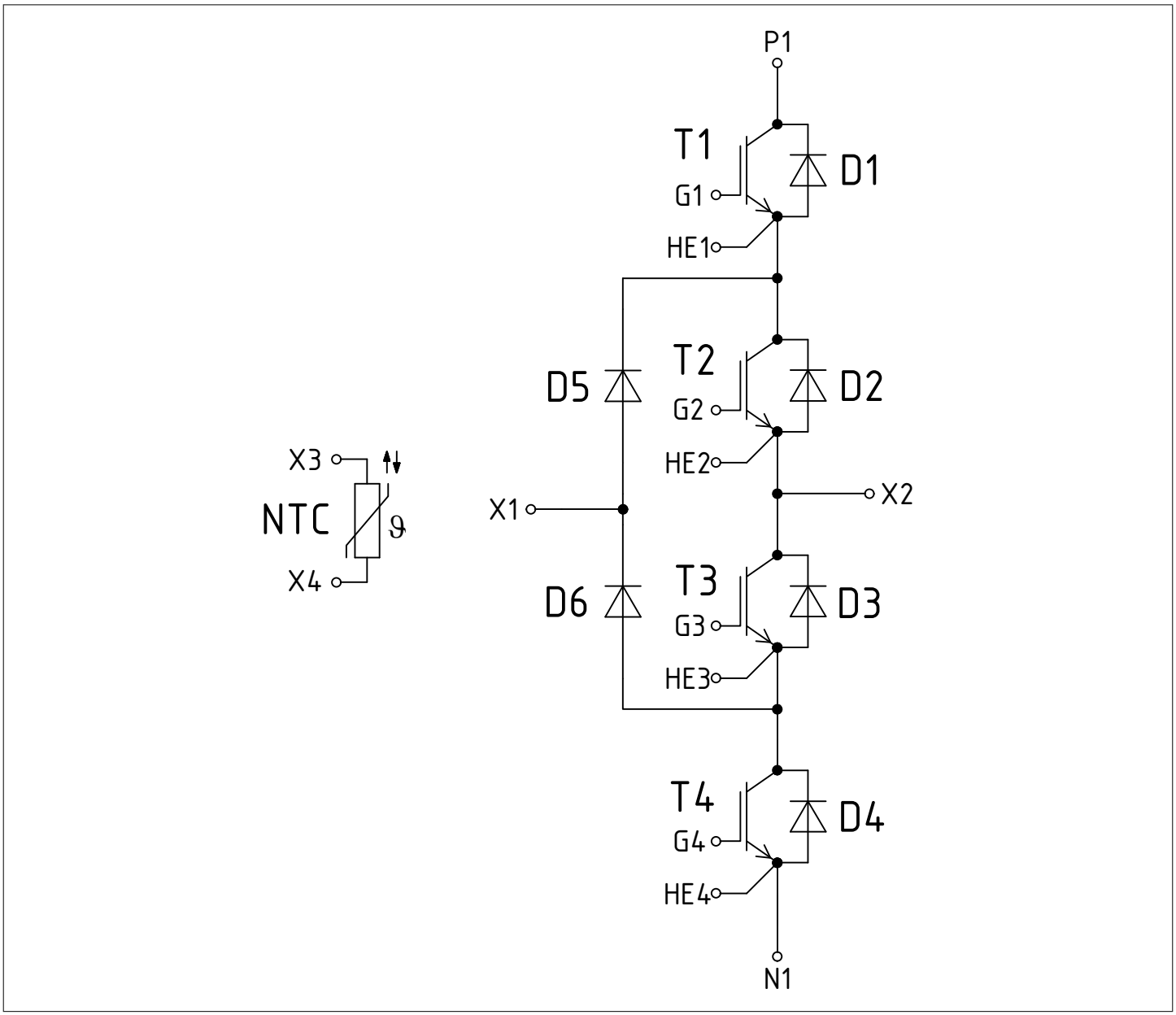

P1
T1
G1
D1
HE1
D5
T2
G2
D2
HE2
X3
NTC
X4
X1
X2
D6
T3
G3
D3
HE3
T4
G4
D4
HE4
N1

図 1

9 パッケージ外形図

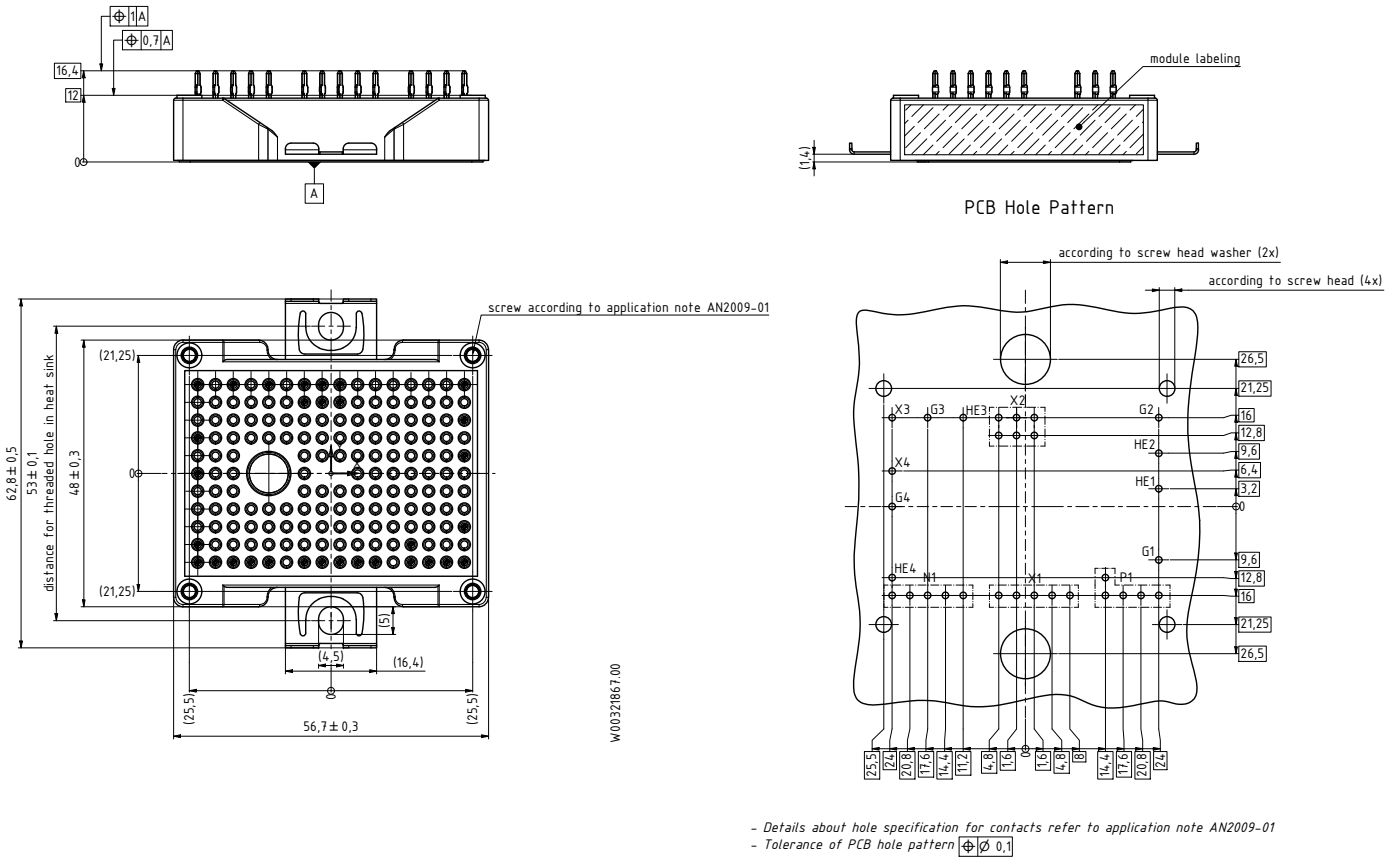


図 2

10 モジュールラベルコード

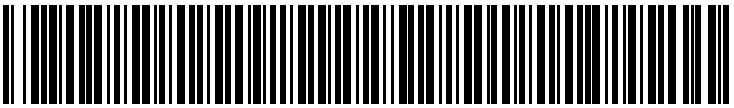
Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	*Content* Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)	*Digit* 1 – 5 6 - 11 12 - 19 20 – 21 22 – 23	*Example* 71549 142846 55054991 15 30
Example	 7154914284655054991530	 7154914284655054991530	

図 3

改訂履歴

文書改訂	発行日	変更内容
1.00	2026-05-28	Initial version

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2026-08-05

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2026 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABR597-001

重要:注意事項

製品(サンプルも含みます。また、ハードウェア、ソフトウェアまたはその両方で構成される製品も含みます。以下同じです。)の販売、提供または引渡しは、インフィニオンテクノロジーズ AG およびその関連会社(以下まとめて「インフィニオン」といいます)、お客様とインフィニオンによって締結された基本契約その他の書面により合意された条件、そのようなの条件がない場合はインフィニオンの適用ある販売条件に従います。お客様の一般的な取引条件またはインフィニオンの販売条件と乖離した条件は、インフィニオンが書面で明示的に同意した場合に限り、インフィニオンを拘束するものとします。

疑義を避けるため、インフィニオンは、第三者の権利を侵害していないことの保証、および特定の使用/目的に対する適合性または商品性の保証などの黙示的保証を負いません。

インフィニオンは、サンプル、アプリケーション、もしくはお客様による製品の具体的な使 用方法、または本書面に記載された例や標準値に関するいかなる情報についても責任いません。

本書に「Preliminary(予備)」「Target(目標)」「Draft(草案)」または「Proposal(提案)」と表示されている場合、インフィニオンは事前の通知なく、本書に記載されたすべての情報をいつでも変更する権利を留保します。インフィニオンによる量産向け製品の開発およびリリースを条件として、当該製品の技術仕様は、そのような表示のないインフィニオン提供の関連するデータシートに定められます。

本書面に記載されているデータは、技術的資格を有する熟練したお客様のご担当者をのみを対象としています。お客様は、意図された用途およびお客様の特定用途に対する製品の適合性を評価し、意図された用途および顧客の特定用途において本書面に含まれるすべての関連技術データを検証する責任を負います。お客様は、意図されたアプリケーションの機能性および安全性を適切に設計、プログラミング、テストし、その使用に関連する法令を遵守してください。

インフィニオンの明示的な承認がない限り、製品は、製品の故障またはその使用による結果が人身傷害につながると合理的に予想されるいかなる用途にも使用しないでください。ただし、上記は、インフィニオンが明示的に設計し、販売した使用分野でお客様が製品を使用することを妨げるものではありません。

インフィニオンは、適用される法律、例えばドイツ著作権法(UrhG)第 44b 条に従って、そのコンテンツを商業的なテキストおよびデータのマイニング(TDM)のために使用する権利を明示的に留保します。

製品にセキュリティ機能が含まれている場合:

いかなるコンピューティング・デバイスも絶対的に安全であることはあり得ないため、製品にセキュリティ対策が施されているにもかかわらず、インフィニオンは、製品に侵入、データの盗難もしくは損失、またはその他の侵害(「セキュリティ侵害」といいます)がないことを保証せず、インフィニオンは、セキュリティ侵害に起因するいかなる責任も負わないものとします。

本書面がソフトウェアを含んでいるまたはソフトウェアに言及している場合:

ソフトウェアは、米国、ドイツ、および世界各国の知的財産権法および条約に基づきインフィニオンが所有しています。インフィニオンはすべての権利を留保し、無断複写、複製および転写を禁じます。お客様はソフトウェアに同梱されたソフトウェア使用許諾契約に従ってのみソフトウェアを使用できます。

ソフトウェア使用許諾契約が適用されない場合、インフィニオンはここに、ソフトウェアの知的所有権に基づき、(a)ソースコード形式で提供されたソフトウェアについて、インフィニオンのハードウェア製品と共に使用する目的のためにのみソフトウェアを修正および複製するための、そして(b)インフィニオンのハードウェア製品上での使用目的に限り、ソフトウェアをバイナリコード形式でエンドユーザーに外部配布するための、個人的、非排他的、譲渡不能なライセンス(サブライセンス不可)をお客様に付与します。それ以外のソフトウェアの使用、複製、変更、翻訳またはコンパイルは禁止されています。製品、技術、納品条件、および価格に関する詳細については、最寄りのインフィニオンオフィスに連絡するか、www.infineon.com にアクセスしてください。